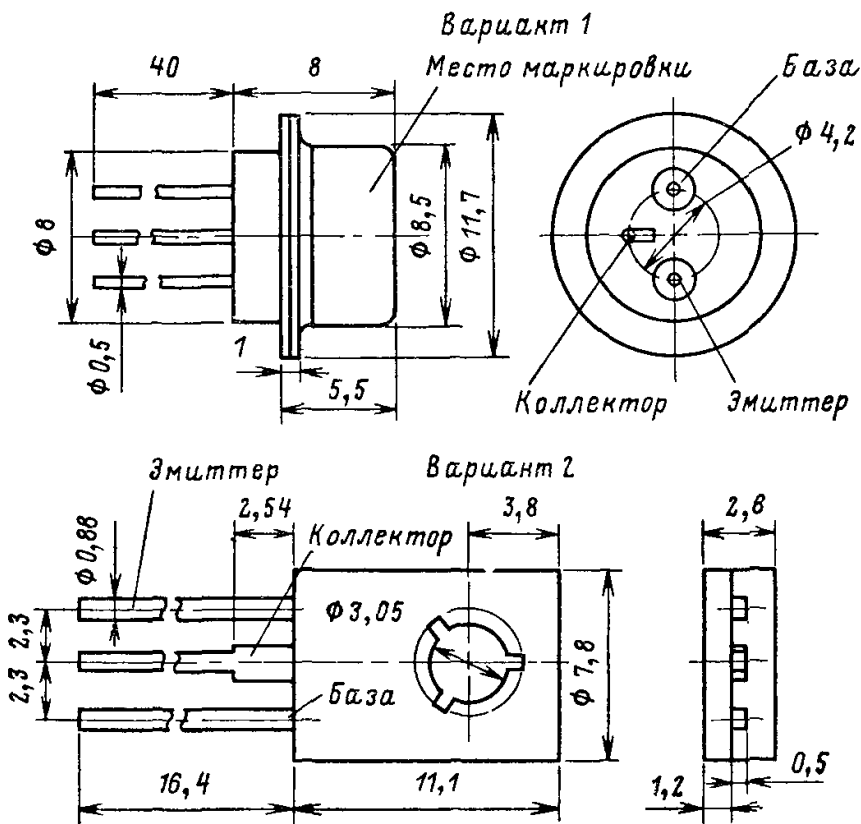


# КТ605А, КТ605Б, КТ605АМ, КТ605БМ

Транзисторы кремниевые меза-планарные *n-p-n* универсальные высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в импульсных, переключательных и усилительных высокочастотных схемах.



Выпускаются в металлостеклянном (КТ605А, КТ605Б – вариант 1) и пластмассовом корпусах с гибкими выводами (КТ605АМ, КТ605БМ – вариант 2) Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 2 г, в пластмассовом не более 1 г

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)  
Энергоатомиздат, 1985

## Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 20$ мА, $I_B = 2$ мА не более . . . . .	8 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $I_Э = 20$ мА, $U_{КБ} = 40$ В	
КТ605А . . . . .	10 – 40
КТ605Б . . . . .	30 – 120
Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КЭ} = 40$ В, $I_Э = 20$ мА не менее . . . . .	40 МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 40$ В, $f = 2$ МГц не более . . . . .	7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$ В, $f = 2$ МГц не более . . . . .	50 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 250$ В не более . . . . .	20 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В не более . . . . .	50 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	
при $T \leq 373$ К . . . . .	300 В
при $T = 423$ К . . . . .	150 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм	
при $T \leq 373$ К . . . . .	250 В
при $T = 423$ К . . . . .	125 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	
при $T \leq 373$ К . . . . .	5 В
при $T = 423$ К . . . . .	2,5 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	100 мА
Импульсный ток коллектора . . . . .	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	
при $T \leq 298$ К . . . . .	0,4 Вт
при $T = 373$ К . . . . .	0,17 Вт
Температура перехода . . . . .	423 К
Тепловое сопротивление переход-среда . . . . .	300 К/Вт
Температура окружающей среды . . . . .	От 233 до 423 К

Примечание Пайку выводов допускается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора не более 5 с  
Температура пайки не должна превышать 533 К

При пайке должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора

Материал взят из источника:

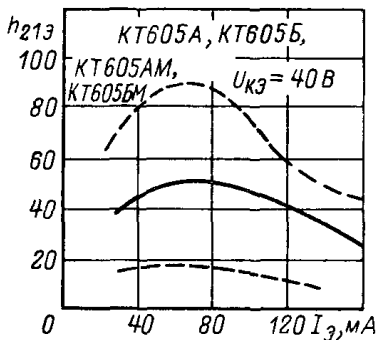
Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

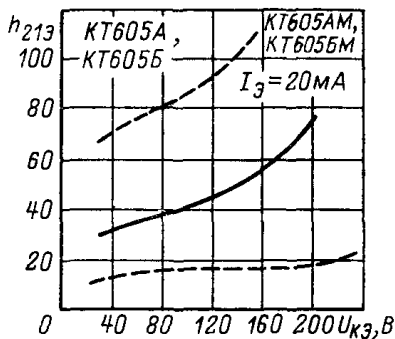
Для транзисторов в пластмассовом корпусе изгиб выводов допускается под углом не более  $90^\circ$  в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса, и на расстоянии не менее 3 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм

При установке транзистора на печатную плату с шагом координатной сетки 2,5 мм допускается одноразовая формовка выводов с их разводкой для совмещения с монтажными отверстиями (контактами)

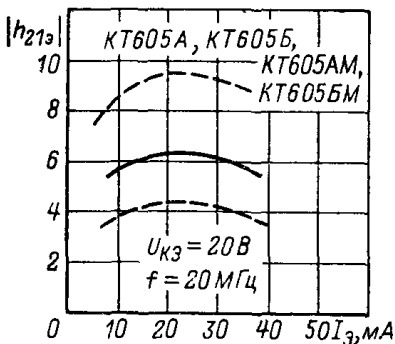
При изгибе и формовке выводов необходимо применять специальные шаблоны, а также обеспечивать неподвижность выводов между местом изгиба и корпусом транзистора Кручение выводов вокруг оси не допускается



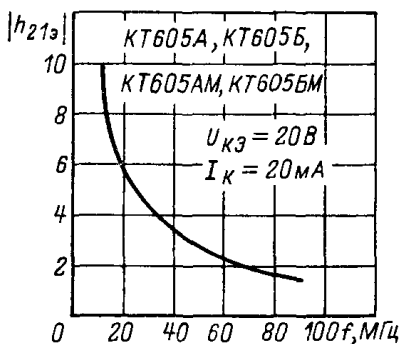
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер

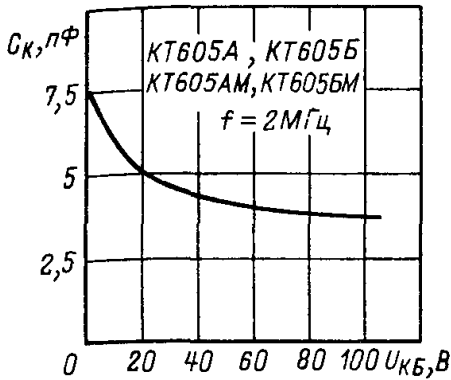


Зона возможных положений зависимости модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера

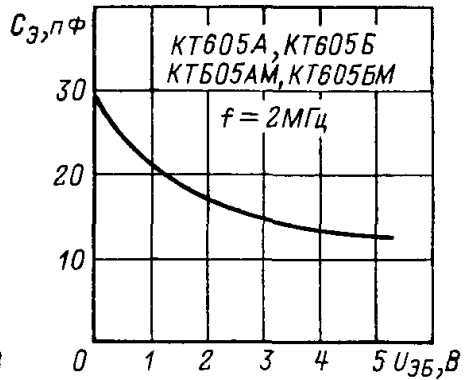


Зависимость модуля коэффициента передачи тока от частоты

Материал взят из источника:



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.



Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)  
Энергоатомиздат, 1985